

PNP/NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波電力増幅用
PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency Power Amplifier

特長 / FEATURES

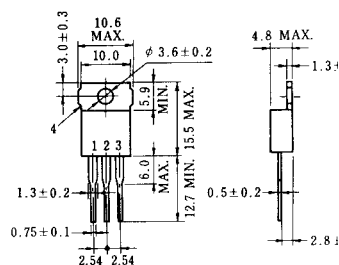
- 絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
2SA1383/2SC3514

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-180/180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	-180/180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	-5/5	V
コレクタ電流	I_C	-100/100	mA
全 損 失	$P_T(T_A = 25^\circ\text{C})$	1.5	W
全 損 失	$P_T(T_C = 25^\circ\text{C})$	10	W
ジャンクション温度	T_J	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

電氣的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -180/180 \text{ V}, I_E = 0$			$-1.0/1.0$	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -3/3 \text{ V}, I_C = 0$			$-1.0/1.0$	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -5/5 \text{ V}, I_C = -1/1 \text{ mA}$	*	90	200/190	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -5/5 \text{ V}, I_C = -10/10 \text{ mA}$	*	100	200	320
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -50/50 \text{ mA}, I_E = -5/5 \text{ mA}$			$-0.16/0.12$	$-0.5/0.5$ V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -50/50 \text{ mA}, I_E = -5/5 \text{ mA}$	*		$-0.8/0.8$	$-1.5/1.5$ V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -10/10 \text{ V}, I_C = -20/20 \text{ mA}$			180/200	MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10/10 \text{ V}, I_E = 0, f = 1 \text{ MHz}$			$4.5/3.2$	$7.0/5.0$ pF
雑音指数	NF	$V_{CE} = -10/10 \text{ V}, I_C = -1/1 \text{ mA}, R_G = 10 \text{ k}\Omega, f = 1 \text{ kHz}$			4/4	dB

外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit : mm)



電極接続

1. Base (B)
2. Collector (C)
3. Emitter (E)
4. Fin (Collector)

EIAJ : SC-46
JEDEC : TO-220AB
IEC : -